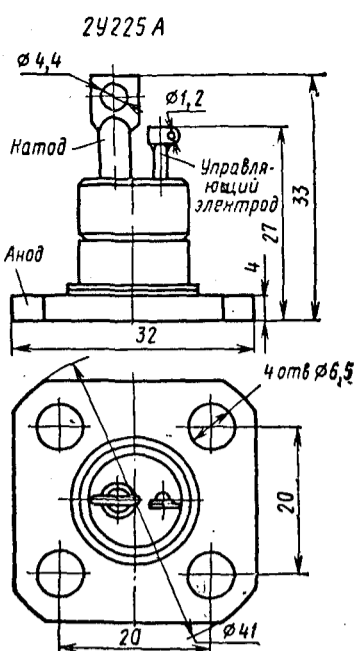


2У225А (ТИЧ4-100-20)

Тиристор кремниевый, диффузионный, триодный, незапираемый, импульсный. Предназначен для применения в мощных высоковольтных импульсных модуляторах. Выпускается в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами. Охлаждение естественное или принудительное. Тип тиристора приводится на корпусе.

Масса тиристора не более 40 г.



Электрические параметры

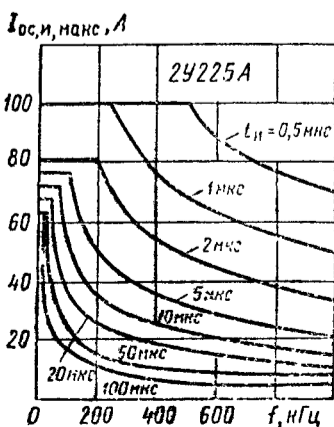
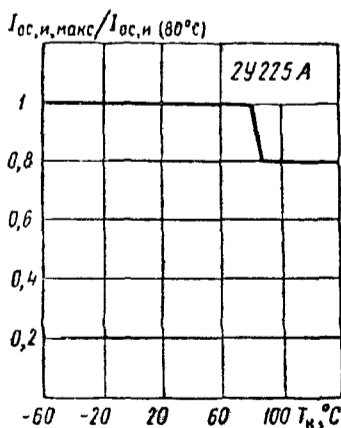
Постоянное напряжение в открытом состоянии при $I_{ос, ср} = 1$ А, не более	3,5 В
Неотпирающее постоянное напряжение при $U_{зс} = U_{зс, и, макс}$ и $T_k = +110^\circ\text{C}$, не менее	0,1 В
Импульсное напряжение управления при $I_{у, пр, и} = 3$ А, $dI_y/dt \geq 30$ А/мкс, $t_y = 1...5$ мкс и $f \leq 1$ кГц, не более	40 В
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии при $U_{зс} = U_{зс, и, макс}$ и $T_k = +110^\circ\text{C}$, не менее	120 В/мкс
Импульсный ток в закрытом состоянии при $U_{зс} = U_{зс, и, макс}$ и $f \leq 60$ Гц, не более:	
при $T = +25^\circ\text{C}$	1,5 мА
при $T = +110^\circ\text{C}$	10 мА
Импульсный обратный ток при $U_{обр} = 600$ В, не более:	
при $T = +25^\circ\text{C}$	1,5 мА
при $T = +110^\circ\text{C}$	10 мА
Время нарастания при $U_{зс, и} = 2000$ В, $I_{ос, и} = 100$ А, $I_{у, пр, и} = 3$ А, $dI_y/dt \geq 30$ А/мкс, $t_y = 1...5$ мкс и $f \leq 1$ кГц, не более	0,1 мкс
Время выключения при $U_{зс} = 1000$ В, $I_{сс, и} = 100$ А, $dU_{зс}/dt = 100$ В/мкс, $t_n = 10$ мкс, $f \leq 60$ Гц и $T_k = +110^\circ\text{C}$	100 мкс
Время задержки при $U_{зс, и} = 2000$ В, $I_{ос, и} = 100$ А, $I_{у, пр, и} = 3$ А, $dI_y/dt \geq 30$ А/мкс, $t_y = 1...5$ мкс и $f \leq 1$ кГц, не более	0,3 мкс

Предельные эксплуатационные данные

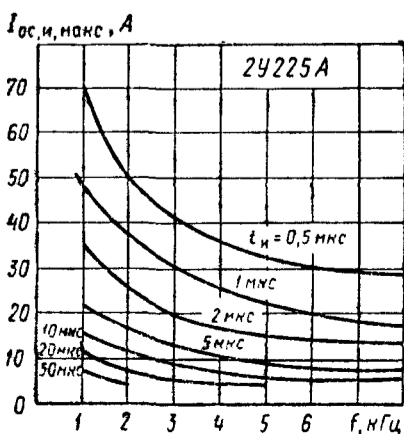
Импульсное напряжение в закрытом состоянии	2000 В
Импульсное обратное напряжение	600 В
Неотпирающее постоянное напряжение управления	0,1 В
Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии	100 В/мкс
Импульсный ток в открытом состоянии при $T_k \leq +80^\circ\text{C}$	100 А
Прямой импульсный ток управления	3 А
Скорость нарастания тока в открытом состоянии	1000 А/мкс
Скорость нарастания прямого тока управления	30 А/мкс
Минимальная длительность прямого тока управления	1 мкс
Частота следования импульсов	10 кГц
Импульсная рассеиваемая мощность управления	200 Вт
Температура окружающей среды	$-60^\circ\text{C} \dots T_k = +85^\circ\text{C}$

Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса для катодного вывода и 4 мм для управляющего электрода при температуре паяльника не свыше $+300^\circ\text{C}$ в течение не более 4 с.

→
Зависимость допустимого импульсного тока в открытом состоянии от температуры корпуса



Зависимости допустимого импульсного тока в открытом состоянии от частоты



Зависимости допустимого импульсного тока в открытом состоянии от частоты